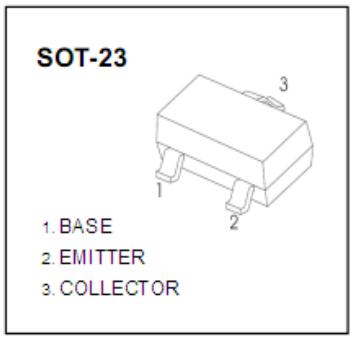
SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

C945（ NPN ）

印章/Marking: CR ·



特点/Features：

1、h_{FE} 线性特性好;
2、低噪声;

用途/Applications：

用于一般放大，与 A733 互补。

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	0.15	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.2	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	℃
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55～150	℃

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CBO)}$	I_C=100μA, I_E=0	60			V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CEO)}$	I_C=1mA, I_B=0	50			V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EBO)}$	I_E=100μA, I_C=0	5			V
集电极截止电流	I_{CBO}	V_{CB}=60V, I_E=0			0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	V_{EB}=5V, I_C=0			0.1	μA
集电极截止电流	I_{CER}	V_{CE}=55V, R=10MΩ			0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	V_{CE}=6V, I_C=1mA	130		400	
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	V_{CE}=6V, I_C=0.1mA	40			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	I_C=100mA, I_B=10mA			0.3	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	I_C=100mA, I_B=10mA			1	V
特征频率	f_T	V_{CE}=6V, I_C=10mA, f=30MHz		150		MHz
输出电容	C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz			3	pF

h_{FE} 分档/Classification of h_{FE}

档位/Rank	L	H
范围/Range	130～200	200～400

典型特性曲线图/Typical Characteristics